**电子元器件(集成电路FLASH)招标参数**

名称：集成电路FLASH

数量：16只

主要性能指标：

1、特点:16M抗辐照闪烁存储器 3.3V单电源NOR型，具备WP保护功能。器件可以利用3.3V工作电压进行在板编程，也可以使用通用EPROM编程器进行编程。（关键指标）

2、封装：采用长管脚48引线陶瓷小外形封装（CSOP48-L）（关键指标）

3、电源电压范围：Vcc -0.5V~4.0V（关键指标）

4、输出短路电流： 260mA （关键指标）

5、存储温度： -65℃~150℃（关键指标）

6、数据保存时间；等效55℃下30年（关键指标）

7、数据擦写次数：25℃下1万次。（关键指标）

8、ESD特性：大于2000V（关键指标）

9、稳态总剂量：≥100krad(Si); （关键指标）

10、器件抗单粒子翻转能力：反转率为1.18\*10-12翻转数/天.位（关键指标）

11、器件单粒子锁定能力：LETthd≥99.8MeV.cm2/mg（关键指标）

12质量等级：CAST C （宇航级），八院下厂监制验收，开具八院元器件质保合格证。（关键指标）